

Reference Number NYA1020001

Dispatch Number 371918

Dispatch Date Oct/28/2003

Notification of Reason(s) for Refusal

Patent Application No. Patent application No.2002-284194

Drafting Date Oct/20/2003

Examiner of JPO Tsutomu Kosugou 9313 2V00

Representative/Applicant Yoshito Fukushima

Applied Provisions Patent Law Section 29(2)

This application should be refused for the reasons mentioned below. If the applicant has any argument against the reason, such argument should be submitted within 60 days from the date on which this notification was dispatched.

Reason(s)

The invention(s) in the claims of the subject application should not be granted a patent under the provision of the Patent Law Section 29(2) since it could have easily been made by persons who have common knowledge in the technical field to which the invention(s) pertains, on the basis of the invention(s) described in the publication(s) listed below which was distributed in Japan or foreign countries of the invention(s)

prior to the filing of the subject application.

Note

[As to claims 1-3 and 8-14]

1. JP 2895868 B

(Refer especially to the description in Scope of Claims for Patent, the description at page 3, right column, line 37 to page 4, upper left column, line 19, and the description at page 13, line 48 to right column, line 7 in the above cited reference 1.)

[As to claims 1-16]

2. JP 2000-150171 A

3.

(Refer especially to the description in Scope of Claims for Patent in the above cited reference 2. It is well-known as described in the cited reference 2 that a fluorocarbon film which is formed of a thin film by plasma is used between layers in order to improve hole transportability (alleviation of energy barriers, etc.), and it is such a mere matter that those skilled in the art would appropriately select whether the fluorocarbon film is to be applied between layers with the conventionally well-known structure. (The cited reference 2 is not a document that particularly excludes the formation of

the thin fluorocarbon film between layers other than layers formed on an anode electrode. Refer also to the description in paragraph [0044] of the specification of the present application.) As the result of carrying out the present invention, no structural differences are found between a completed thin film (especially of fluorocarbon) of the present invention and the thin film described in the cited reference 2.

Records of Search on Prior Art

- Field of Search

IPC Seventh Edition H05B33/14, 33/10, 33/22

DB

- Prior Art

The records of Search on prior art are not part of the reasons for rejection.

拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願 2 0 0 2 - 2 8 4 1 9 4
起案日	平成 1 5 年 1 0 月 2 0 日
特許庁審査官	越河 勉 9 3 1 3 2 V 0 0
特許出願人代理人	福島 祥人 様
適用条文	第 2 9 条第 2 項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から 6 0 日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

この出願の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第 2 9 条第 2 項の規定により特許を受けることができない。

記

【請求項 1 乃至 3、8 乃至 1 4 について】

1, 特許第 2 8 9 5 8 6 8 号公報

(特に、上記引用例 1 の特許請求の範囲の記載、第 3 頁右欄第 3 7 行目乃至第 4 頁左上欄第 1 9 行目までの記載、及び、第 1 3 頁第 4 8 行目乃至右欄第 7 行目までの記載等を参照のこと。)

【請求項 1 乃至 1 6 について】

2, 特開 2 0 0 0 - ^{1 5 0 1 7 1}~~1 5 6 0 7 1~~ 号公報

3,

(特に、上記引用例 2 の特許請求の範囲の記載等を参照のこと。正孔輸送性能改善のため(エネルギー障壁の緩和等)、プラズマによる薄膜形成をしたフッ化炭素膜を層間に用いる点は、引用例 2 に記載されたように公知であり、該膜を従来周知の層構成間に適用するかは、当業者で有れば適宜選択する程度の事項にすぎない(引用例 2 は、アノード電極上に形成する以外の層間に該薄膜形成することを格別排除する文献ではない。また、本願明細書の段落【0 0 4 4】の記載も参照のこと)。なお、本願発明の実施の結果、完成した薄膜層(特にフッ化炭素)は、引用例 2 に記載された薄膜と、構成上の差は認められない。

先行技術文献調査結果の記録

- ・ 調査した分野 I P C 第 7 版 H05B33/14、33/10、33/22
 D B 名
- ・ 先行技術文献

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。この拒絶理由通知書に不明な点がある場合、または、この案件について面接を希望する場合には、特許審査第1部応用光学 越河(こすごう)まで
連絡先 Tel.03-3581-1101 内線 3230～3232、FAX 03-3501-0478